

Предложенная схема оптического цифрового перемножителя с использованием источников света с различными длинами волн позволяет простым образом реализовать умножение на основе операции аналоговой свертки. При считывании данных с жидкокристаллического транспаранта бихроматическим излучением возможно одновременное выполнение двух логических операций, необходимых для выполнения операции суммирования с переносом.

Литература

- [1] Whitehouse H. J., Speiser J. M. // Aspects of Signal Processing. 1977. Vol. 2. 90 p.
- [2] Родес У. Т., Джиллфойл П. С. // ТИИЭР. 1984. Т. 72. № 7. 80 с.
- [3] Guilfoyle P. // Opt. Eng. 1984. Vol. 23. P. 20—25.
- [4] Psaltis D., Casasent D. // Proc. SPIE. 1980. Vol. 98. P. 232.
- [5] Li Y., Eichmann G., Alfaro R. R. // Opt. commun. 1987. Vol. 64. N 2. P. 99.
- [6] Беловолов М. И., Дианов Е. М., Гурьянов А. Н. // Электросвязь. 1987. № 11. С. 54.
- [7] Seki M., Koboashi K., Odagizi Y. // Electronics Letters. 1982. Vol. 18. N 6. P. 35—37.
- [8] Fatehi M. T., Wastlundt K. C. // Appl. Opt. 1981. Vol. 20. N 13. P. 2250.
- [9] Всеводкин Г. Г., Дианов Е. М., Кузнецов А. А., Недеев С. М. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 22. Вып. 22. С. 1373—1377.

Институт общей физики АН СССР
Москва

Поступило в Редакцию
14 марта 1988 г.

02; 12

Журнал технической физики, т. 59, в. 5, 1989

РАССЕЯНИЕ БЫСТРЫХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИОНОВ ВОДОРОДА ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ИХ С АТОМАМИ Не И МОЛЕКУЛАМИ Н₂

Р. Н. Ильин, В. И. Сахаров, И. Т. Серенков

В инжекторах термоядерных реакторов предполагается использование пучков быстрых ($E > 100$ кэВ) атомов водорода, полученных путем нейтрализации ускоренных отрицательных ионов при столкновении последних с атомами и молекулами. Для выбора параметров инжектора необходима информация о необходимости пучка, в частности об ее изменениях в процессе транспортировки и нейтрализации, т. е. об упругом и неупругом рассеянии ионов Н⁻. Рассеяние при нейтрализации быстрых ($E=50—150$ кэВ) ионов Н⁻ исследовалось экспериментально в работе [1], где изучались зависимости угловых характеристик пучков нейтральных частиц от толщины мишени, но не были получены такие характеристики элементарных процессов, как дифференциальные сечения и не рассматривалось упругое рассеяние. В работах [2—4] приведены результаты расчетов дифференциальных сечений нейтрализации и упругого рассеяния быстрых ионов Н⁻ на различных мишениях. Интересной особенностью результатов расчетов упругого рассеяния следует считать наличие минимума на угловых зависимостях дифференциальных сечений, связанного с особенностями структуры иона Н⁻.

Задачей настоящей работы является измерение дифференциальных по углу сечений нейтрализации и упругого рассеяния быстрых ионов Н⁻ при столкновении их с атомами и молекулами с целью получения более детальной, чем в работе [1], информации об элементарных процессах и проведения сопоставлений с теорией, в частности проверки наличия особенностей в упругом рассеянии.

В качестве мишней были выбраны молекулярный водород, являющийся основным компонентом остаточного газа в инжекторах, и гелий. Энергии столкновений составляли 100 и 200 кэВ. Диапазон углов рассеяния 0—10⁻³ рад.

Методика эксперимента

Первичный пучок ионов Н⁻, сформированный коллиматором, направлялся в камеру столкновений. Выходящий из камеры пучок рассеянных частиц проходил пролетную часть и попадал на неподвижный детектор, представляющий собой шевронную сборку из двух 60-миллиметровых МКП. Коллиматор состоял из двух вертикальных щелей шириной 10 мкм

высотой 0.6 мм на расстоянии 80 см друг от друга. Длина камеры столкновений составляла 16.5 см, пролетной части (от центра камеры до детектора) — 327 см.

Перед детектором была расположена измерительная щель шириной 35 мкм и высотой 4 см. Толщина газовой мишени при измерении сечений не превышала $2 \cdot 10^{14}$ см⁻², что обеспечивало однократность столкновений. Получение угловых зависимостей осуществлялось путем подачи ступенчатых напряжений на пару вертикальных плоскопараллельных пластин, расположенных непосредственно перед камерой столкновений, и измерения интенсивности сигнала при каждом значении разности потенциалов между пластинами. Данный метод является модификацией известного способа измерения расходимости пучков (см., например, [5]). Съем сигналов с детектора и выдача на пластины ступенчатых напряжений велись в автома-

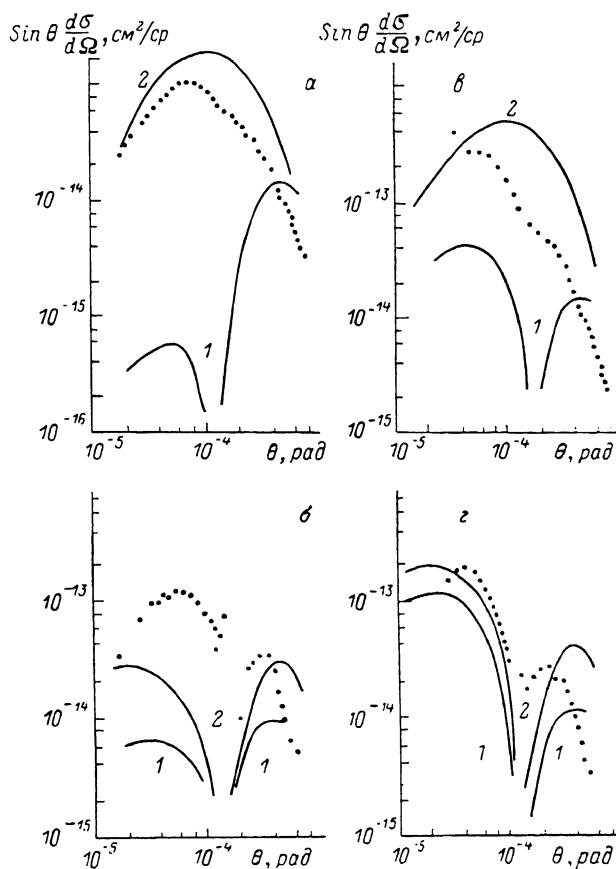


Рис. 1. Дифференциальные сечения упругого рассеяния ионов H⁻ на He (a, б) и H₂ (в, г) при энергиях 100 (а, в) и 200 кэВ (б, г).

Точки — эксперимент, сплошные линии — расчет.

тическом режиме с помощью микроЭВМ, согласованной с пересчетным прибором и цифроаналоговым преобразователем. Профиль пучка, рассеянного на мишени (зависимость интенсивности от угла отклонения первичного пучка), определялся как разность профилей, полученных при рабочем и остаточном давлениях в камере столкновений, что позволяло избежать ошибок, связанных с рассеянием на щелях и в остаточном газе. Форма угловых зависимостей дифференциальных сечений получалась путем применения к экспериментальным кривым процедуры восстановления, сходной с описанной в работе [6]. Необходимость этого обусловлена использованием в установке ленточных пучков и протяженной щели перед детектором. Абсолютные значения дифференциальных сечений нейтрализации получались путем калибровки нормированных кривых на полные сечения, взятые из работы [7], абсолютные значения сечений упругого рассеяния определялись из геометрических условий эксперимента. В качестве контрольного опыта аналогичным образом было измерено абсолютное дифференциальное сечение нейтрализации на энергию 100 кэВ и проведено сравнение с сечением, полученным с помощью калибровки, при этом расхождение кривых не превышало 20 %.

Полученные результаты и их обсуждение

а) Упругое рассеяние ионов в H^- . Результаты измерений приведены на рис. 1. Там же для сравнения приведены расчетные кривые. Кривые 1 соответствуют расчетам в первом борновском приближении, выполненным методом, изложенным в работе [2]. Наблюдается большое расхождение между расчетными и экспериментальными кривыми, особенно в области малых углов для гелиевой мишени.

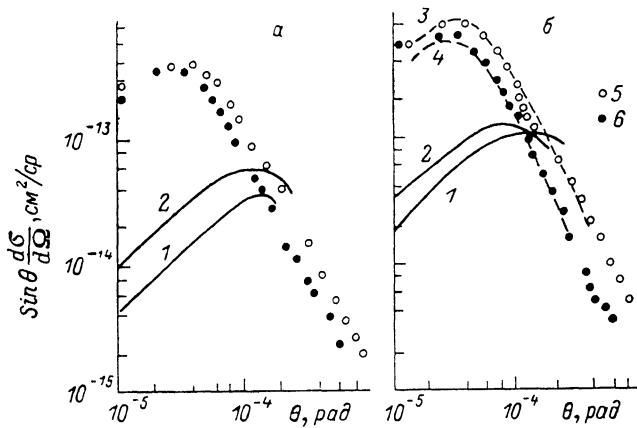


Рис. 2. Дифференциальные сечения нейтрализации ионов H^- на He (а) и H_2 (б).
1, 2 — расчет тем же методом, что и в [2]; 3, 4 — расчет на основе данных [3]; 5, 6 — эксперимент при $E=100$ и 200 кэВ соответственно. E , кэВ: 1, 3 — 100 , 2, 4 — 200 .

Лучшее согласие с экспериментом дает расчет предлагаемым нами способом, являющимся модификацией метода из работы [2]. Он заключается в замене квадрата форм-фактора отрицательного иона $|F_{00}^{H^-}(q)|^2$ величиной

$$\Phi(q) = (\cos \varphi - F_{00}^{H^-}(q) - 1)^2 + \sin^2 \varphi,$$

где

$$\varphi = (2/v) \ln \sin \frac{\theta}{2} + \varphi_0, \quad \exp(i\varphi_0) = \frac{\Gamma\left(1 - \frac{i}{v}\right)}{\Gamma\left(1 + \frac{i}{v}\right)}.$$

Здесь v — относительная скорость сталкивающихся частиц, θ — угол рассеяния. Величина $4\pi^2/q^4\Phi(q)$ является приближенным выражением для сечения рассеяния быстрой заряженной частицы на ион H^- при рассмотрении этого процесса как рассеяния на искаженном кулоновском потенциале методом, близким к изложенному в работе [8] и отличающимся от последнего тем, что в нашем случае выражение для некулоновской части амплитуды рассеяния f^N находилось методом Борна, а не суммированием парциальных волн. Для кулоновской части амплитуды f^C бралось точное выражение [8]. Таким образом, подстановка величины $\Phi(q)$ вместо $|F_{00}^{H^-}(q)|^2$, хотя и не является строго обоснованной, позволяет, на наш взгляд, лучше учесть особенности структуры иона H^- . Результаты расчетов дифференциальных сечений упругого рассеяния вышеизложенным методом приведены на рис. 1, кривые 2.

Из рис. 1 видно, что минимум на угловых зависимостях дифференциальных сечений проявляется отчетливо при $E=200$ кэВ в той области углов, где расчет обоими методами дает резкий провал. При $E=100$ кэВ экспериментальные кривые идут сравнительно гладко, предсказываемая расчетом по методу, описанному в работе [2], особенность нами обнаружена не была.

б) Рассеяние при нейтрализации ионов в H^- . На рис. 2 представлены дифференциальные сечения нейтрализации иона H^- и результаты расчетов сечения в борновском приближении. Расчеты выполнены тем же методом, что и в работе [2]. Из сопоставления с экспериментом видно, что положение расчетных максимумов оказывается сдвинутым в область больших углов. Это объясняется тем, что, как показано в работах [3, 4], метод расчета, применяемый в работе [2], не учитывает того факта, что движение нейтрального атома, образовавшегося в результате столкновения иона H^- с мишенью, существенно отлично от движения центра масс системы атом + удаленный электрон, а, поскольку в эксперименте фикси-

руется угол рассеяния нейтральной частицы, это отличие необходимо принимать во внимание при расчете сечений нейтрализации в лабораторной системе координат. Оценки, проведенные на основании данных работы [3], показывают, что максимумы расчетных кривых должны быть сдвинуты в сторону меньших углов.

Как следует из результатов, полученных в работах [2, 4], форма дифференциальных сечений нейтрализации ионов H^- при столкновениях с молекулами H_2 весьма мало отличается от случая, когда мишенью являются атомы H. Этот факт позволяет использовать результаты работы [3] для сопоставления с экспериментальными данными по нейтрализации H^- на H_2 , при этом для приведения к нужным значениям энергии следует воспользоваться правилами масштабирования углов, предложенными авторами работы [8], и провести калибровку на полные сечения. Результаты соответствующих расчетов, также приведенные на рис. 2, показывают хорошее согласие между экспериментальными зависимостями и кривыми, полученными вышеописанным методом.

Таким образом, в работе измерены дифференциальные по углу сечения упругого рассеяния и рассеяния при нейтрализации быстрых ионов H^- с энергиями 100 и 200 кэВ, проведено сопоставление полученных результатов с теорией, при энергии 200 кэВ экспериментально показано существование предсказанной теорией особенности в упругом рассеянии ионов H^- , а также подтверждена необходимость учета различия траекторий атома и центра масс системы атом+удаленный электрон при расчетах сечений нейтрализации быстрых ионов H^- .

В заключение авторы выражают глубокую благодарность А. Д. Хахаеву, А. Г. Босенко и Я. Е. Штивельману за создание комплекса аппаратуры автоматизации эксперимента и первичной обработки информации.

Литература

- [1] Дьячков Б. А., Зиненко В. И., Казанцев Г. В. // ЖТФ. 1977. Т. 47. Вып. 2. С. 416—420.
- [2] Lee Y. T., Chen J. C. Y. // Phys. Rev. 1979. Vol. A19. N 2. P. 526—533.
- [3] Genoni T. C., Wright L. A. // J. Phys. B. 1980. Vol. 13. N 2. P. L61—L64.
- [4] Wright L. A., Franz M. R., Genoni T. C. // Phys. Rev. 1985. Vol. A32. N 2. P. 1215—1216.
- [5] Ames L. L. // Nucl. Instrum. and Methods. 1978. Vol. 151. N 3. P. 363—369.
- [6] Горбунов Е. П. // Диагностика плазмы. Вып. 3. М., 1973. С. 358—366.
- [7] Barnett C. F., McDowell E. W., Gilbody H. B. Atomic data for controlled fusion research. Oak Ridge, 1977. 316 р.
- [8] McDowell M. R. G. // Phys. Rev. 1968. Vol. 175. N 1. P. 189—196.
- [9] Momt H., Messer G. Теория атомных столкновений. М., 1969. 756 с.

Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе АН СССР
Ленинград

Поступило в Редакции
5 мая 1988 г.

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ РАСТВОРА-РАСПЛАВА НА ПАРАМЕТРЫ СЛОЕВ InGaAsP ($\lambda_g=1.3$ мкм)

Л. А. Луполова, А. В. Сырбу, В. П. Яковлев

Полученные в последнее время серьезные достижения в изготовлении высокоеффективных InGaAsP/InP лазерных гетероструктур ($\lambda_g=1.3$ мкм) выращиванием из растворов в расплаве [1, 2] определяют необходимость дальнейшего исследования этого процесса, который, как было показано, может конкурировать по предельным параметрам структур с такими изощренными методами выращивания, как молекулярная эпитаксия и газофазное выращивание из металлоорганических соединений. Проведенные ранее исследования жидкофазного роста InGaAsP с длиной волны краевой люминесценции $\lambda_g=1.14$ [3, 4] и 1.2 мкм [5] показали, что основные параметры слоев (толщина слоя d , рассогласование параметров решетки $\Delta a/a$ и длина волны краевой люминесценции λ_g) зависят от переохлаждения раствора-расплава ΔT , из которого проводится выращивание. Вместе с тем в работе [6] сообщается, что при выращивании InGaAsP с $\lambda_g=1.3$ мкм λ_g и $\Delta a/a$ не зависят от переохлаждения раствора-расплава. Однако этот результат был получен в результате выращивания при постоянной температуре из растворов в расплаве с разным содержанием фосфора. Необходимо отметить, что в про-